

MG06200S-BN4MM



Agency Approvals

AGENCY	AGENCY FILE NUMBER
	E71639

Features

- High short circuit capability, self limiting short circuit current
- $V_{CE(sat)}$ with positive temperature coefficient
- Fast switching and short tail current
- Free wheeling diodes with fast and soft reverse recovery
- Low switching losses

Applications

- High frequency switching application
- Medical applications
- Motion/servo control
- UPS systems

Module Characteristics ($T_c = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)

Symbol	Parameters	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
$T_{J \max}$	Max. Junction Temperature				175	$^\circ\text{C}$
$T_{J \text{ op}}$	Operating Temperature		-40		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	Storage Temperature		-40		125	$^\circ\text{C}$
V_{isol}	Insulation Test Voltage	AC, t=1min		3000		V
CTI	Comparative Tracking Index		350			
Torque	Module-to-Sink	Recommended (M6)	3		5	N·m
Torque	Module Electrodes	Recommended (M5)	2.5		5	N·m
Weight				160		g

Absolute Maximum Ratings ($T_c = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)

Symbol	Parameters	Test Conditions	Values	Unit
IGBT				
V_{CES}	Collector - Emitter Voltage	$T_J = 25^\circ\text{C}$	600	V
V_{GES}	Gate - Emitter Voltage		± 20	V
I_C	DC Collector Current	$T_c = 25^\circ\text{C}$	300	A
		$T_c = 60^\circ\text{C}$	200	A
I_{CM}	Repetitive Peak Collector Current	$t_p = 1\text{ms}$	400	A
P_{tot}	Power Dissipation Per IGBT		600	W
Diode				
V_{RRM}	Repetitive Reverse Voltage	$T_J = 25^\circ\text{C}$	600	V
$I_{F(AV)}$	Average Forward Current	$T_c = 25^\circ\text{C}$	300	A
		$T_c = 60^\circ\text{C}$	200	A
I_{FRM}	Repetitive Peak Forward Current	$t_p = 1\text{ms}$	400	A
I^2t		$T_J = 125^\circ\text{C}$, $t = 10\text{ms}$, $V_R = 0\text{V}$	3500	A^2s

Life Support Note:

Not Intended for Use in Life Support or Life Saving Applications

The products shown herein are not designed for use in life sustaining or life saving applications unless otherwise expressly indicated.

Power Module

600V 200A IGBT Module

Electrical and Thermal Specifications ($T_c = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)

Symbol	Parameters	Test Conditions		Min	Typ	Max	Unit
IGBT							
V _{GE(th)}	Gate - Emitter Threshold Voltage	V _{CE} =V _{GE} , I _C =3.2mA		4.9	5.8	6.5	V
V _{CE(sat)}	Collector - Emitter Saturation Voltage	I _C =200A, V _{GE} =15V, T _J =25°C			1.45		V
		I _C =200A, V _{GE} =15V, T _J =125°C			1.6		V
I _{CES}	Collector Leakage Current	V _{CE} =600V, V _{GE} =0V, T _J =25°C				1	mA
		V _{CE} =600V, V _{GE} =0V, T _J =125°C				5	mA
I _{GES}	Gate Leakage Current	V _{CE} =0V, V _{GE} =±15V, T _J =125°C		-400		400	nA
R _{Gint}	Integrated Gate Resistor				2		Ω
Q _{ge}	Gate Charge	V _{CC} =300V, I _C =200A , V _{GE} =±15V			2.15		μC
C _{ies}	Input Capacitance	V _{CE} =25V, V _{GE} =0V, f =1MHz			13		nF
C _{res}	Reverse Transfer Capacitance				0.38		nF
t _{d(on)}	Turn - on Delay Time	V _{CC} =300V I _C =200A R _G =2.0Ω V _{GE} =±15V Inductive Load	T _J =25°C		150		ns
			T _J =125°C		160		ns
t _r	Rise Time		T _J =25°C		30		ns
			T _J =125°C		40		ns
t _{d(off)}	Turn - off Delay Time		T _J =25°C		340		ns
			T _J =125°C		370		ns
t _f	Fall Time		T _J =25°C		60		ns
			T _J =125°C		70		ns
E _{on}	Turn - on Energy		T _J =25°C		1		mJ
			T _J =125°C		1.55		mJ
E _{off}	Turn - off Energy		T _J =25°C		5.65		mJ
			T _J =125°C		6.9		mJ
I _{SC}	Short Circuit Current	t _{psc} ≤6μS , V _{GE} =15V; T _J =125°C, V _{CC} =360V			1000		A
R _{thJC}	Junction-to-Case Thermal Resistance (Per IGBT)				0.25		K/W
Diode							
V _F	Forward Voltage	I _F =200A , V _{GE} =0V, T _J =25°C			1.55		V
		I _F =200A , V _{GE} =0V, T _J =125°C			1.5		V
I _{RRM}	Max. Reverse Recovery Current	I _F =200A , V _R =300V di _F /dt=-5700A/μs T _J =125°C			230		A
Q _{rr}	Reverse Recovery Charge				17		μC
E _{rec}	Reverse Recovery Energy				5.2		mJ
R _{thJCD}	Junction-to-Case Thermal Resistance (Per Diode)				0.45		K/W

Figure 1: Typical Output Characteristics

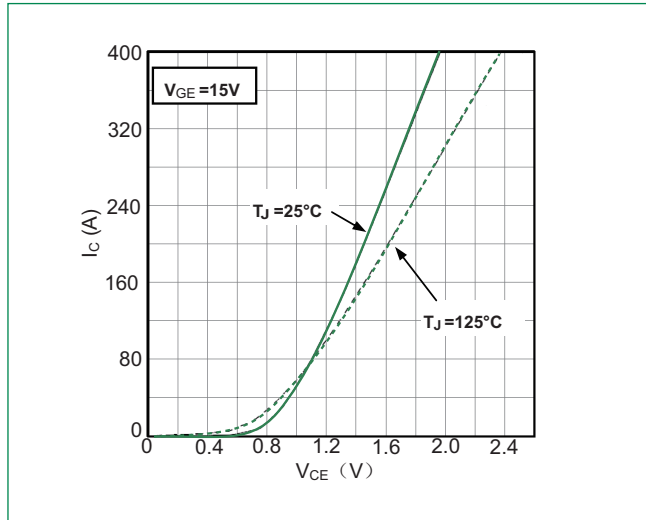


Figure 2: Typical Output characteristics

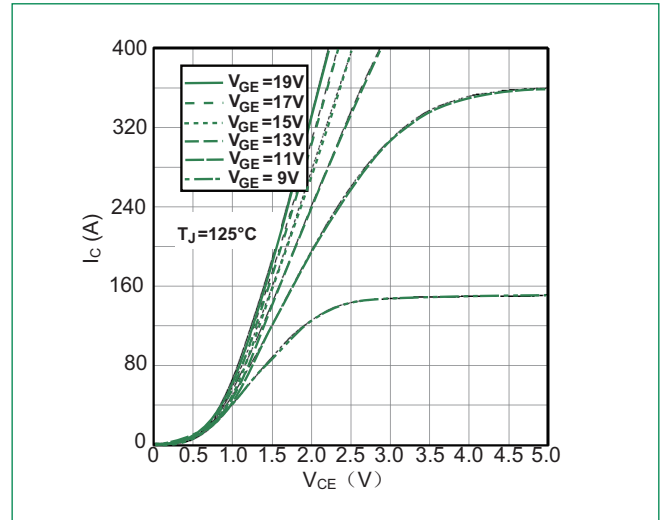


Figure 3: Typical Transfer characteristics

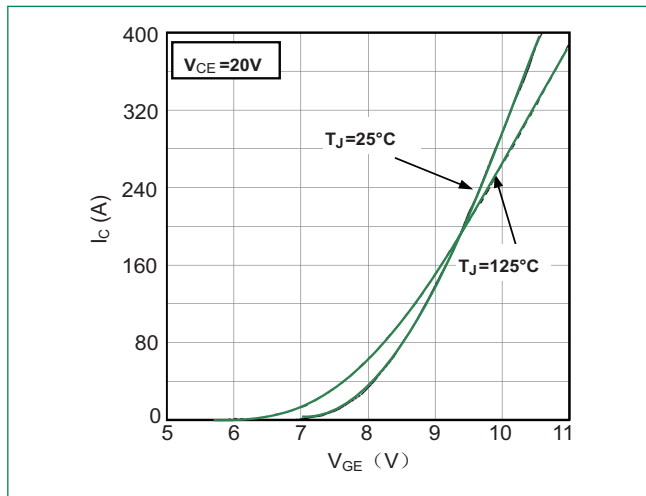


Figure 4: Switching Energy vs. Gate Resistor

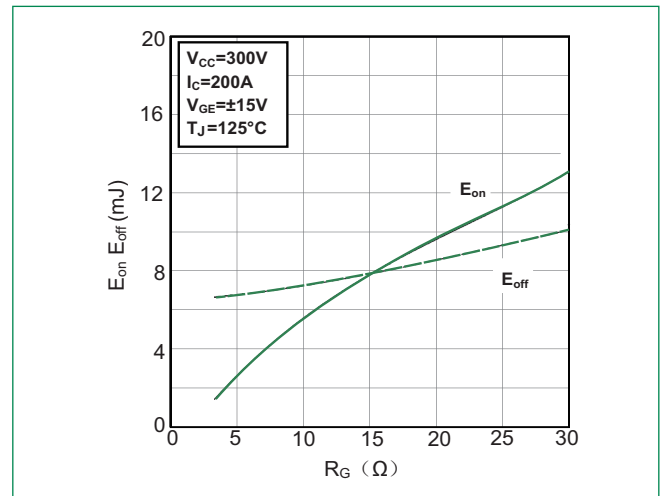


Figure 5: Switching Energy vs. Collector Current

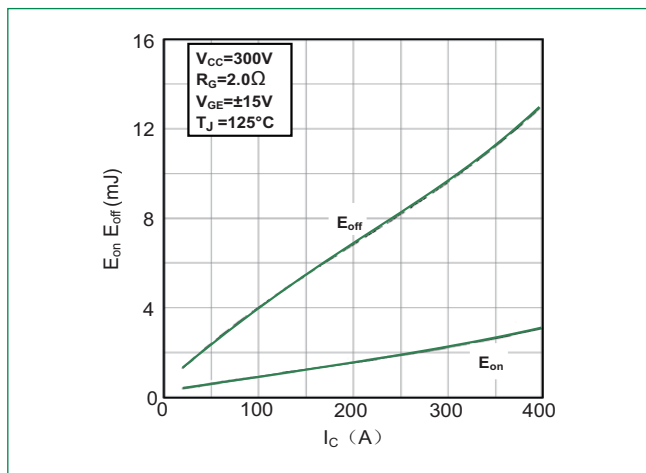


Figure 6: Reverse Biased Safe Operating Area

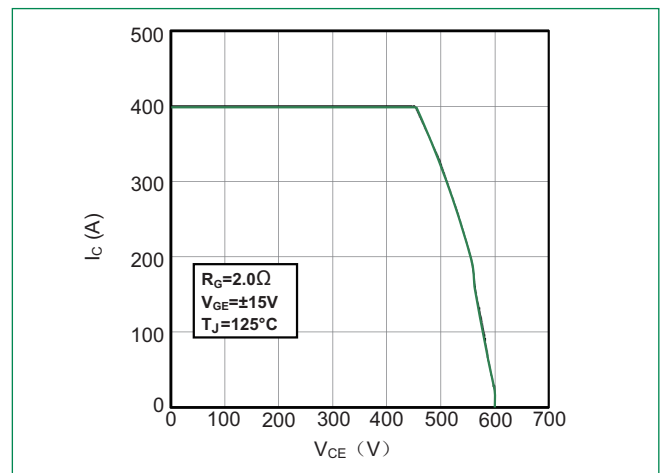


Figure 7: Diode Forward Characteristics

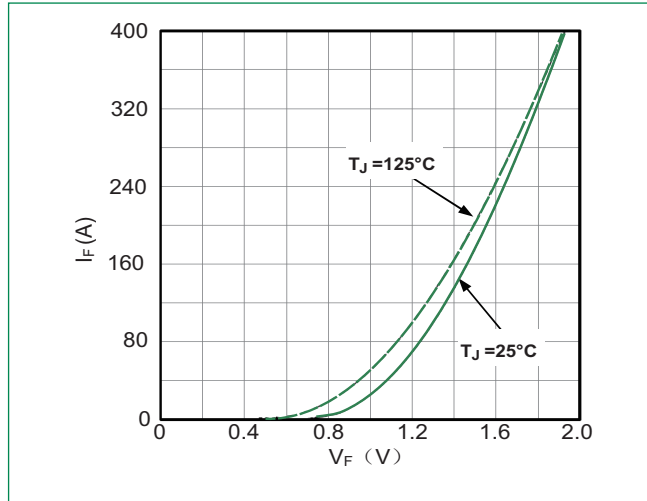


Figure 8: Switching Energy vs. Gate Resistor

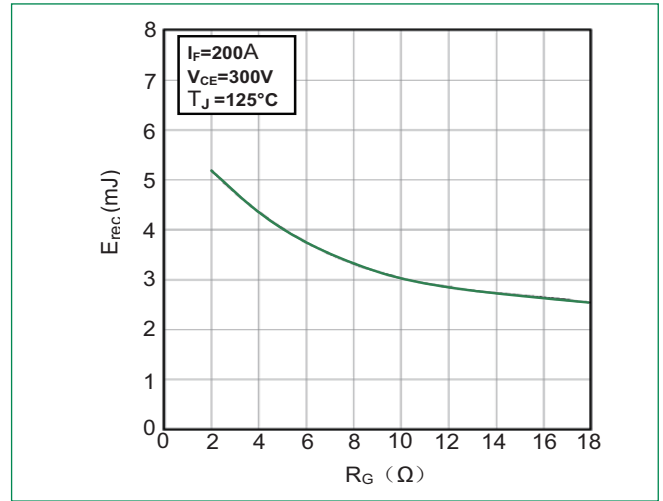


Figure 9: Switching Energy vs. Forward Current

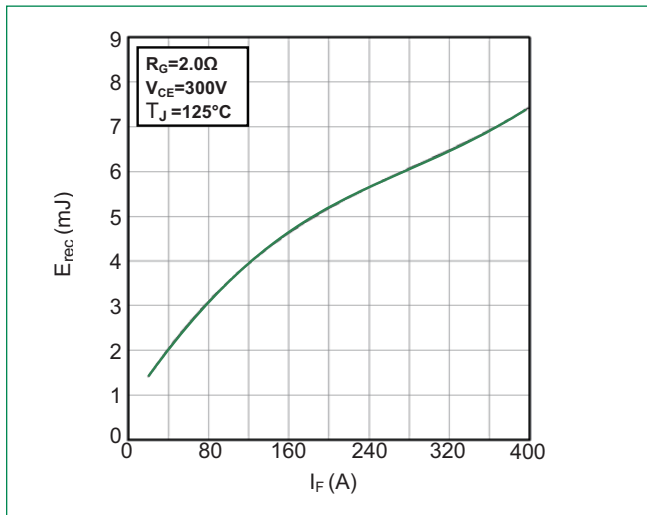
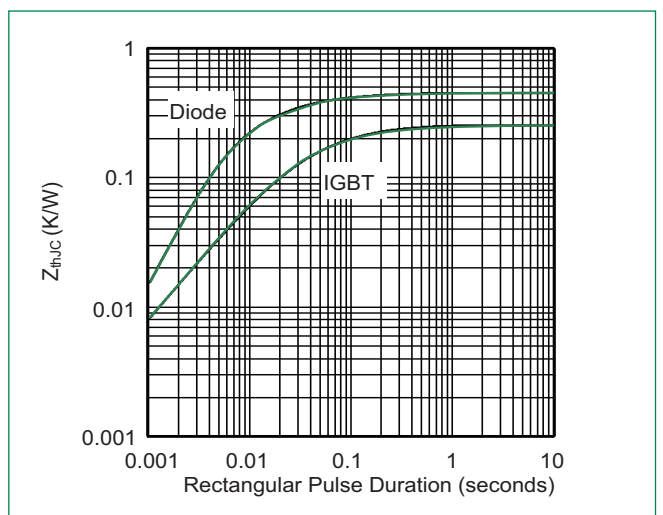
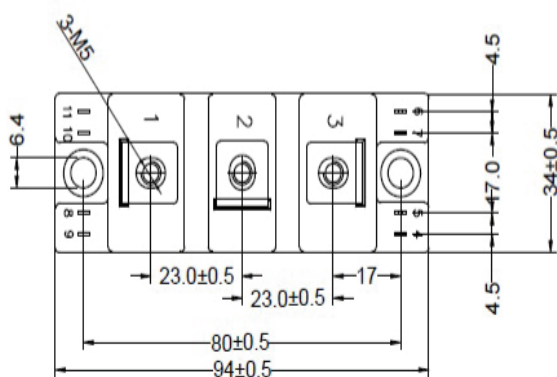
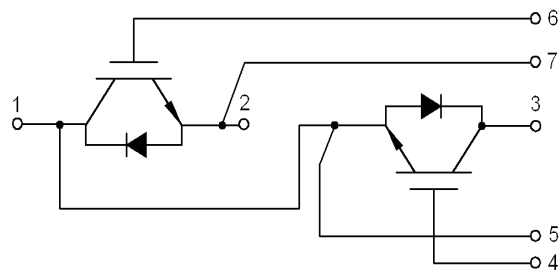


Figure 10: Transient Thermal Impedance

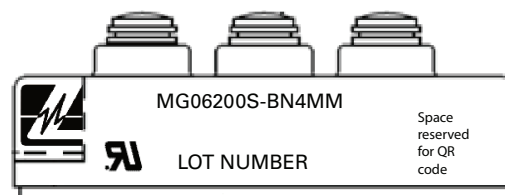
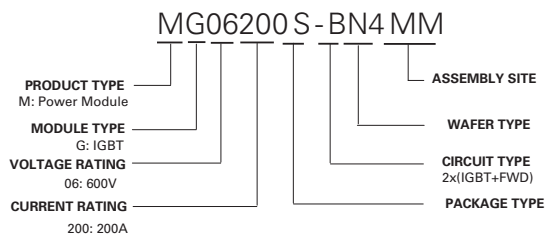


Circuit Diagram



Part Number	Marking	Weight	Packing Mode	M.O.Q
MG06200S-BN4MM	MG06200S-BN4MM	160g	Bulk Pack	100

Part Marking System





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331